## Лабораторная работа по твердотельной электронике

## № 28: Исследование униполярных транзисторов с управляющим переходом

Яромир Водзяновский Б04-852

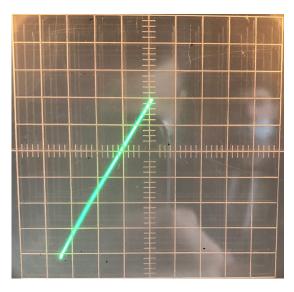


Рис. 1: ВАХ малый линейный сигнал: X = 0.02 V, Y = 0.05 mA

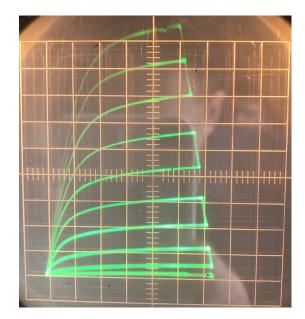


Рис. 2: BAX: X = 1 V, Y = 0.5 mA

1. Рассчитаем ток насыщения по формуле для диода Шоттки:

$$I = I_s \cdot \left( e^{\frac{V}{\theta \cdot \varphi_T}} - 1 \right),\,$$

положим  $\theta \approx 2, \;\; \varphi_T \approx 0.026 \; V.$  Сопротивление на данном участке (рис. 1) :

$$R = 219 \text{ Om}$$

тогда получим:

$$I_s \approx 0.234 \ mA$$

2. Измерим приращение тока стока.

Определим напряжение запирания:

$$U_{
m 3an} pprox -1.9 \ V$$

Кривизна графика в окресности точки  $I_0=3\ mA,\ U_0=4\ V$  :

$$S = \frac{I_{\text{ctok}}}{V_{\text{gatb}}} \approx 3.5 \ mA/V$$